

Характеристики наборов биполярных транзисторов

I_{CBO}	Обратный ток коллектора	Δh_{21E}	Разброс статических коэф. пер. тока
I_{EBO}	Обратный ток эмиттера	U_{BESAT}	Напряжение насыщения база-эмиттер
I_{TIT20}	Ток утечки между транзисторами	U_{CESAT}	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
h_{21E}	Стат. коэф. пр. пер. т. в сх. с общ. эм. в реж. бол. сиг.	ΔU_{BE}	Разброс напряжения база-эмиттера

Тип	Параметр								Тип корпуса	Технические условия	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Кол-во транзисторов	
	$I_{CBO}, \text{нА}$	$I_{EBO}, \text{нА}$	h_{21E}	$I_{TIT20}, \text{нА}$	Δh_{21E}	$U_{BESAT}, \text{В}$	$U_{CESAT}, \text{В}$	$\Delta U_{BE}, \text{В}$							
198НТ1А	<50	<100	30;200	<50	<15	<0,8	<0,2	3	401.14-5	АЕЯР.431410.245ТУ	СА3046	Матрица транзисторо в NPN типа	-60 ; - ; +125	5	
198НТ1Б			-					10							
198НТ1В			-					3							
198НТ2А			30;200					<0,1							10
198НТ2Б			-					-							
198НТ3	<75	30;250	<0,85	<0,5	5	-									
198НТ5А	<100			<0,75											
198НТ5Б	<75			<0,5											
198НТ6А	<100			<0,75											
198НТ6Б	<75			<0,5											
198НТ7А	<100			<0,75											
198НТ7Б	<75			<0,5											
198НТ8А	<100			<0,75											
198НТ8Б	<75			<0,5											
198НТ8Б	<100			<0,75											